
	<h2>SI7462DP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7462DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 2.6A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7462DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1646 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7462DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 2.6A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	1646 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 2.6A (Ta) 1.9W (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	1.9W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	130 mOhm @ 4.1A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI7462DP-T1-GE3CT

SI7462DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7462DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7462DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7462DP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7461DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 8.6A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7461DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 8.6A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7463ADP-T1-GE VISHAY VISHAY DFN8</p>	 <p>SI7462DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 200V 2.6A PPAK SO-8</p>
 <p>SI7463DP-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 40V 11A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7462DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 2.6A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7462DP-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 200V 2.6A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7461DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 8.6A PPAK SO-8</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ SI7456CDP-T1-GE3	↔ SI7456CDP-T1-GE3	⇒ SI7456DDP-T1-GE3	D SI7456DDP-T1-GE3	⇒ SI7456DP
⊕ SI7456DP-T1-E3	⊕ SI7456DP-T1-E3	D SI7456DP-T1-GE3	⇒ SI7456DP-T1-GE3	⇒ SI7458DP-T1-E3
⊕ SI7459DP-T1-E3	⊕ SI7459DP-T1-E3	⊕ SI7459DP-T1-GE3	↔ SI7459DP-T1-GE3	⇒ SI7460DP
D SI7460DP-T1-E3	⊕ SI7460DP-T1-E3	⊕ SI7460DP-T1-GE3	⊕ SI7460DP-T1-GE3	⇒ SI7461DP-T1-E3
⇒ SI7461DP-T1-E3	↔ SI7461DP-T1-GE3	⊕ SI7461DP-T1-GE3	⊕ SI7462DP-T1-E3	⇒ SI7462DP-T1-E3
↔ SI7462DP-T1-GE3	⇒ SI7463ADP-T1-GE3	D SI7463ADP-T1-GE3	⊕ SI7463DP-T1-GE3	⊕ SI7463DP-T1-GE3
⊕ SI7464DP-T1-E3	D SI7464DP-T1-E3	⇒ SI7464DP-T1-GE3	↔ SI7464DP-T1-GE3	⇒ SI7465DP-T1-E3
⊕ SI7465DP-T1-E3	⊕ SI7465DP-T1-GE3	↔ SI7465DP-T1-GE3	⇒ SI7470DP-T1-GE3	⇒ SI7476DP-T1-GE3
⊕ SI7476DP-T1-GE3	⊕ SI7478DP	⊕ SI7478DP-T1-E3	D SI7478DP-T1-E3	⇒ SI7478DP-T1-GE3
↔ SI7478DP-T1-GE3	⊕ SI7483ADP	⊕ SI7483ADP-T1-E3	⊕ SI7483ADP-T1-E3	⇒ SI7483ADP-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited